

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 3 部門第 4 区分
 【発行日】平成 17 年 3 月 3 日 (2005.3.3)

【公表番号】特表 2002-518593 (P2002-518593A)
 【公表日】平成 14 年 6 月 25 日 (2002.6.25)
 【出願番号】特願 2000-554901 (P2000-554901)
 【国際特許分類第 7 版】

C 2 3 C	14/34	
B 3 2 B	15/02	
C 2 2 C	27/02	
// C 2 2 F	1/00	
C 2 2 F	1/18	
【F I】		
C 2 3 C	14/34	A
B 3 2 B	15/02	
C 2 2 C	27/02	
C 2 2 F	1/00	6 0 4
C 2 2 F	1/00	6 0 6
C 2 2 F	1/00	6 8 5 Z
C 2 2 F	1/00	6 9 1 C
C 2 2 F	1/00	6 9 4 A
C 2 2 F	1/18	G

【誤訳訂正書】
 【提出日】平成 15 年 3 月 10 日 (2003.3.10)
 【誤訳訂正 1】
 【訂正対象書類名】明細書
 【訂正対象項目名】0 0 2 7
 【訂正方法】変更
 【訂正の内容】
 【0 0 2 7】

ターゲットの面にわたりそして厚みを通じて、最大結晶粒サイズが 5 0 μ m であり一様な (1 0 0) 結晶組織 (テキスチュア ; t e x t u r e) を有するタンタルターゲット (純度が 9 9 . 9 5 % 以上) ブランクを得る本方法の 1 実施態様を以下に示す。

(1) 摩擦なしアブセット鍛造処理及びローリング処理を組み合わせることにより熱機械的処理中ピレットを加工する。

(2) アブセット処理中摩擦なし鍛造処理を行い、接触面に沿った正の摩擦を発生させ処理安定性を増加する。

(3) アブセット処理のパラメータをを予め決定し、蓄積した歪を増加させ、プレス能力を低下させ、ローリング処理を効果的にする。

(4) ローリング条件のパラメータを予め決定し、製品の歪分布をほぼ均等にし、形状を円筒状 (スパッタリングターゲットのため) にする。

(5) 静的再結晶温度の最低温度をアニーリング処理温度として使用する。

(6) 従来では得られない極めて微細で一様の構造及び強く一様なテクスチュアを有するスパッタリングターゲットを製造する。

【誤訳訂正 2】
 【訂正対象書類名】明細書
 【訂正対象項目名】図面の簡単な説明
 【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【図面の簡単な説明】

【図 1】

図 1 はタンタルターゲットの中央部の粒径構造の 100×25 ミクロンの顕微鏡写真を示す。

【図 2】

図 2 はタンタルターゲットの半径方向の中間部の粒径構造の 100×25 ミクロンの顕微鏡写真を示す。

【図 3】

図 3 はタンタルターゲットの縁部の粒径構造の 100×25 ミクロンの顕微鏡写真を示す。

【図 4】

図 4 は $[100]$ キュービックテキスチュアの中央部を示す反転磁極図である。

【図 5】

図 5 は $[100]$ キュービックテキスチュアの半径方向の中間部を示す反転磁極図である。

【図 6】

図 6 は $[100]$ キュービックテキスチュアの縁部を示す反転磁極図である。